









	<h2 style="color: red;">FQD30N06TF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD30N06TF</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 22.7A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD30N06TF.pdf 2.FQD30N06TF.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 32368 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD30N06TF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 22.7A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	32368 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 22.7A (Tc) 2.5W (Ta), 44W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 44W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	22.7A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	45 mOhm @ 11.4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	945pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQD30N06TF ist neu im Original, Suche FQD30N06TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD30N06TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD30N06TF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD30N06LTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 24A DPAK</p>	 <p>FQD30N06TF_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 22.7A DPAK</p>	 <p>FQD30N06LTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 24A DPAK</p>	 <p>FQD30N06TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 22.7A DPAK</p>
 <p>FQD30N06TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 22.7A DPAK-3</p>	 <p>FQD30N06LTM-NL FAIRCHILD FQD30N06LTM-NL FAIRCHILD</p>	 <p>FQD30N06LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 24A DPAK</p>	 <p>FQD30N06TF_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 22.7A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD2N60A	↔ FQD2N60C	⇒ FQD2N60CTF	D FQD2N60CTF	⇒ FQD2N60CTF-NL
⊕ FQD2N60CTF_F080	⊗ FQD2N60CTF_F080	D FQD2N60CTM	⇒ FQD2N60CTM	⇒ FQD2N60TM
⊗ FQD2N60TM	⊕ FQD2N65C	⊗ FQD2N80TM	↔ FQD2N80TM	⇒ FQD2N80TM-NL
D FQD2N90TF	⊗ FQD2N90TF	⊕ FQD2P25TF	⊗ FQD2P25TM	⇒ FQD30N06
⇒ FQD30N06L	↔ FQD30N06LTF	⊗ FQD30N06LTF	⊕ FQD30N06LTM	⇒ FQD30N06LTM
↔ FQD30N06TF	⇒ FQD30N06TF_F080	D FQD30N06TF_F080	⊗ FQD30N06TM	⊕ FQD30N06TM
⊗ FQD30P06	D FQD3N25T	⇒ FQD3N30TF	↔ FQD3N30TF	⇒ FQD3N30TM
⊕ FQD3N30TM	⊗ FQD3N40TM	↔ FQD3N40TM	⇒ FQD3N50C	⇒ FQD3N50C/CS
⊗ FQD3N50CTF	⊕ FQD3N50CTF	⊗ FQD3N50CTM	D FQD3N50CTM	⇒ FQD3N60C
↔ FQD3N60CS	⊗ FQD3N60CTF	⊕ FQD3N60CTM	⊗ FQD3N60CTM_WS	⇒ FQD3N60TF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited